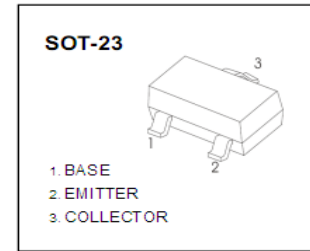


SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
印章 /Marking : J3Y
用途 /Applications :

用于 功率放大电路 , 与 S8550 互补。


极限参数 /Absolute maximum ratings(Ta=25 °C)

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	V_{CB0}	40	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	V_{CE0}	25	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	V_{EB0}	5	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	I_C	0.5	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	P_C	0.3	W
结温/Junction Temperature	T_j	150	°C
储存温度/Storage Temperature	T_{stg}	-55~150	°C

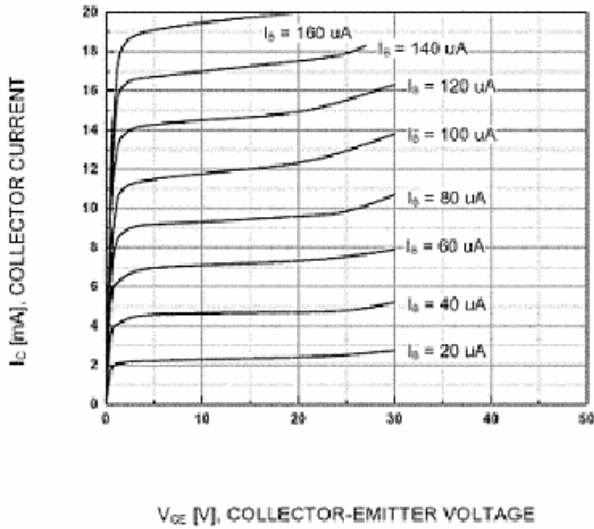
电性能参数 /Electrical characteristics (Ta=25 °C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	$V_{BR(CB0)}$	$I_C=100\mu A, I_E=0$	40			V
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CE0)}$	$I_C=1mA, I_B=0$	25			V
发射极-基极击穿电压	$V_{BR(EB0)}$	$I_E=100\mu A, I_C=0$	5			V
集电极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB}=40V, I_E=0$			0.1	μA
发射极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB}=5V, I_C=0$			0.1	μA
集电极发射极穿透电流	I_{CE0}	$V_{CE}=20V, I_B=0$			0.1	μA
直流电流增益	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=1V, I_C=50mA$	120		350	
直流电流增益	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=1V, I_C=500mA$	50			
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500mA, I_B=50mA$			0.6	V
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$	$I_C=500mA, I_B=50mA$			1.2	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=6V, I_C=20mA, f=30MHz$	150			MHz

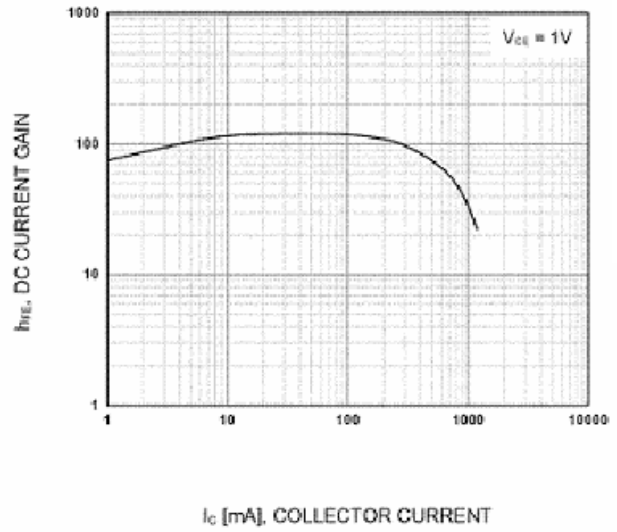
hFE档位 /Classification of hFE (1)

档位/Rank	L	H
范围/Range	120~200	200~350

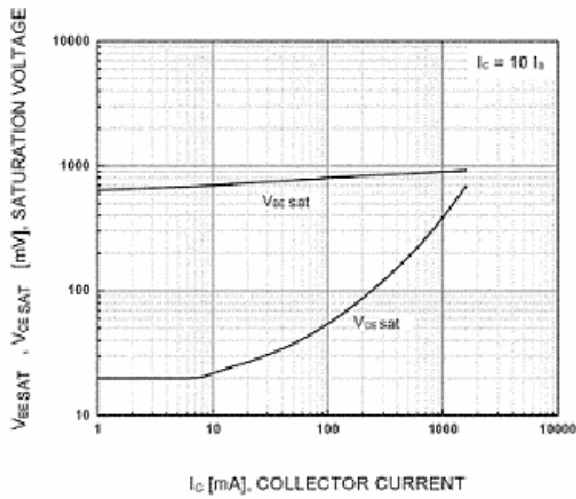
典型特性曲线图 /Typical Characteristics



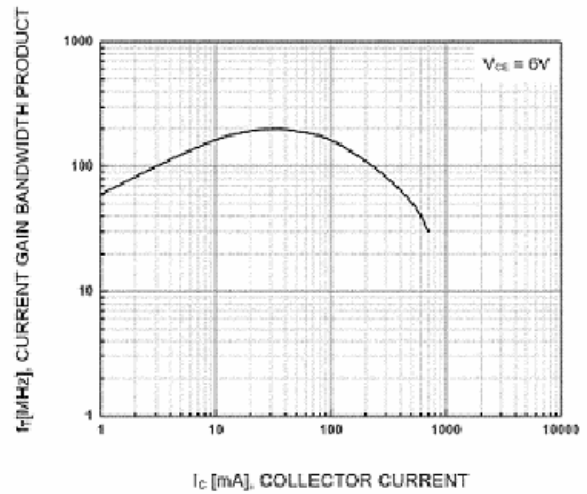
Static Characteristic



DC current Gain



Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage



Current Gain Bandwidth Product